

# HPI-147A66

HPI-147A66 は、4つの受光面が1チップに形成されたシリコンPIN形フォトダイオードです。

The HPI-147A66 is a silicon PIN photodiode has four active areas (photodiodes) integrated in one chip.

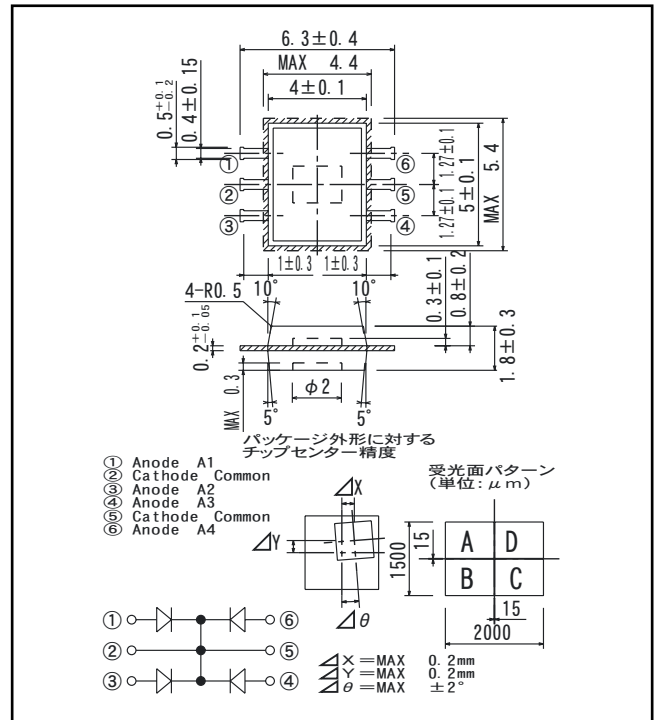
### ■特長 FEATURES

- 4分割フラット樹脂モールド
- 高速応答
- Four segmented photodiodes/Flat plastic package
- High speed response

### ■用途 APPLICATIONS

- X-Y位置検出用
- X-Y position sensors

### ■外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)



### ■最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item	Symbol	Rating	Unit
逆電圧 Reverse voltage	$V_R$	30	V
許容損失 Power dissipation	$P_D$	30	mW
動作温度 Operating temp.	$T_{opr.}$	-25~+85	°C
保存温度 Storage temp.	$T_{stg.}$	-40~+100	°C
半田付温度 Soldering temp.*1	$T_{sol.}$	260	°C

\*1. リード根元より2mm離れた所で5秒

For MAX. 5 seconds at the position of 2 mm from the resin edge

### ■電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

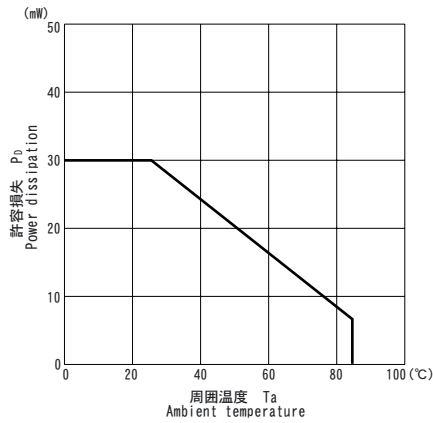
(Ta=25°C)

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
光電流 Light current	$I_L$	$V_R=10V, E_v=1000Lx$ *2		10		$\mu A$
感度 Sensitivity	S	$V_R=10V, \lambda_p=680nm$	0.43	0.48		A/W
暗電流 Dark current	$I_d$	$V_R=10V$			10	nA
端子間容量 Capacitance	$C_t$	$V_R=10V, f=1MHz$		5.0		pF
分光感度 Spectral sensitivity	$\lambda$			450~1050		nm
ピーク感度波長 Peak wavelength	$\lambda_p$			800		nm
半値角 Half angle	$\Delta\theta$			$\pm 65$		°
応答時間(立上り) Rise time	$t_r$	$V_R=10V, R_L=1k\Omega,$		10		ns
応答時間(立下り) Fall time	$t_f$	$\lambda_p=780\sim 800nm$		10		ns

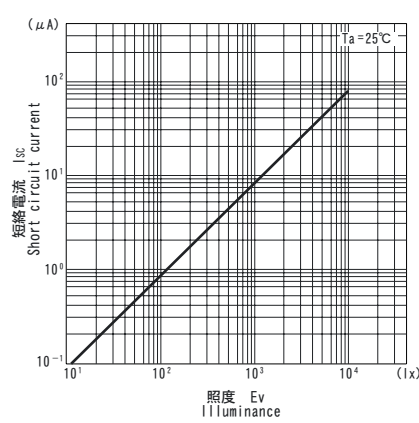
\*2. 色温度=2856K標準タングステン電球  
Color temp. = 2856K standard Tungsten lamp

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容確認をお願い致します。

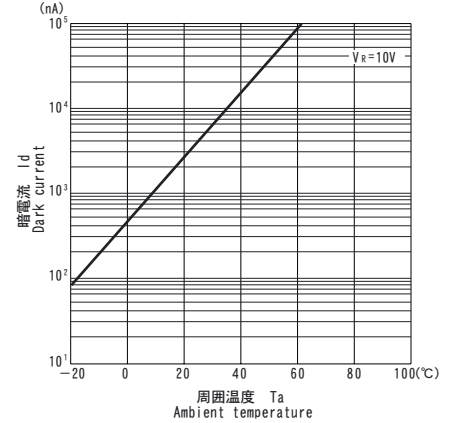
■許容損失/周囲温度  $P_D/T_a$



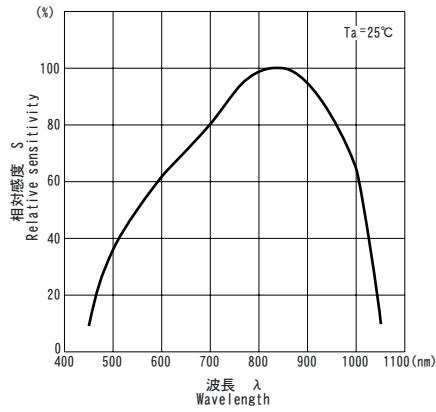
■短絡電流/照度特性  $I_{sc}/E_v$



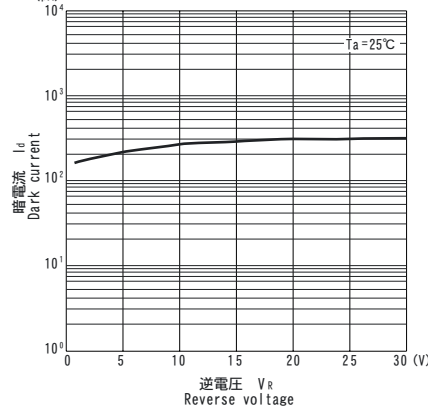
■暗電流/周囲温度特性  $I_d/T_a$



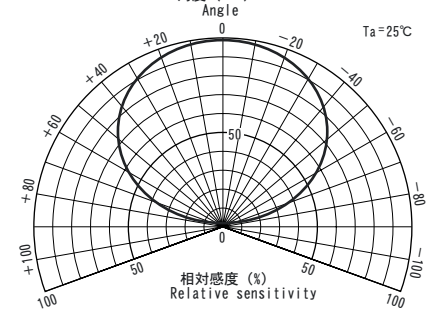
■分光感度特性



■暗電流/逆電圧特性  $I_d/V_R$



■指向特性



■端子間容量/逆電圧特性  $C_t/V_R$

